



## 瑞晶電子成功完成30nm 2Gb DDR3 DRAM試產

April 18, 2011

瑞晶電子(4932)為台灣專業DRAM製造商，以先進製程提供高品質、高效能之DRAM產品。18日，瑞晶電子宣布，已成功試產出使用爾必達所開發30nm製程的2Gb DDR3晶片，良率符合預期；未來將加速進行製程轉換，預計於2011年下半年全面導入量產，並同時生產4Gb DDR3 DRAM。

### 此次試產成功之2Gb DDR3

DRAM產品，係使用爾必達所開發，低耗電、高效能之全新30nm製程技術，每片晶圓產出晶粒量比40nm製程多出45%，可有效降低生產成本。瑞晶電子總經理陳正坤指出：「此次試產結果，不論品質、良率均相當令人滿意，我們將依循此超前進度之表現，繼續加速進行製程轉換，希望能在2011年下半年，將月產能8.5萬片的全產線，百分之百轉換完成。此外也將生產4Gb DDR3 DRAM，以滿足高階產品的需求。」

### 爾必達社長暨執行長坂本幸雄先生亦表示：「新的2Gb DDR3

DRAM不但是2011年的主流產品，更特別適用於消費性電子產品。我要特別感謝瑞晶全體同仁的努力，並希望這項傑出產品可以早日量產。」

新的2Gb DDR3 DRAM傳輸率高達1600Mbps，但只需1.35伏特的電壓，並兼容DDR3-Plus(Seamless BL4

access)標準，可有效提升消費性電子產品的表現。同時，瑞晶電子也將推出4Gb DDR3 DRAM之大容量記憶體產品，持續提供市場高品質、高競爭力之DRAM產品。

聯絡人：郭佩珊(886-4-25218000 ext.8091)